

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3974792号
(P3974792)

(45) 発行日 平成19年9月12日(2007.9.12)

(24) 登録日 平成19年6月22日(2007.6.22)

(51) Int. Cl.

F I

G O 2 F 1/035 (2006.01)

G O 2 F 1/035

G O 2 B 6/12 (2006.01)

G O 2 B 6/12 H

G O 2 F 1/03 (2006.01)

G O 2 F 1/03 5 O 2

請求項の数 1 (全 27 頁)

(21) 出願番号	特願2002-31304 (P2002-31304)	(73) 特許権者	000005223
(22) 出願日	平成14年2月7日(2002.2.7)		富士通株式会社
(65) 公開番号	特開2003-233047 (P2003-233047A)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
(43) 公開日	平成15年8月22日(2003.8.22)	(74) 代理人	100092978
審査請求日	平成16年9月3日(2004.9.3)		弁理士 真田 有
前置審査		(72) 発明者	土居 正治
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内
		(72) 発明者	杉山 昌樹
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内
		(72) 発明者	中澤 忠雄
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光導波路デバイス及び光デバイス

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電気光学効果を有する長辺、短辺を有する基板と、
該基板上に前記長辺方向に並んで形成され、光学的に結合された第1、第2のマッハツェンダ型干渉計と、

前記基板の第1の短辺側に設けられた前記第1のマッハツェンダ型干渉計からの出力光の一部の放射である第1放射光に対応した位置に設けられた第1モニタ部と、

前記基板の第2の短辺側に設けられた前記第2のマッハツェンダ型干渉計からの出力光の一部の放射である第2放射光に対応した位置に設けられた第2モニタ部と、を備え、

前記基板は、前記第1モニタ部、前記第2モニタ部で検出可能な該第1放射光、該第2放射光がともに、前記第2の短辺を含む側面内から出力されるように、前記長辺の長さ、前記側面の前記第2の短辺以外の辺の長さが設定され、

前記第1モニタ部と前記第2モニタ部を前記第2の短辺を含む側面側に設け、

前記第1モニタ部と前記第2モニタ部は、前記基板の厚み方向にずらして配置された、ことを特徴とする光導波路デバイス。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光通信に用いられる光導波路デバイス及び光デバイス（光変調器）に関する。

10

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、超高速・広帯域の光通信ネットワークシステムを実現するために、外部変調方式の光変調器（外部変調器）に対する期待が高まっている。

特に、光信号の長距離伝送を可能とするために、広帯域での高速変調特性及び耐分散特性に優れている、 LiNbO_3 （ニオブ酸リチウム，リチウムナイオベート；LN）を用いたマッハツェンダ型（MZ）の光変調器（MZ型LN光変調器）の開発が進められている。

【 0 0 0 3 】

このMZ型LN光変調器では、温度ドリフトやDCドリフト等によって動作点が変動してしまうため、これを補償するために、バイアス電圧を印加するようにしている。一般に、光変調器の出力側にモニタ用PD（フォトディテクタ，光検出部）を設け、MZ型光導波路の出力側のY分岐光導波路の分岐部分から放射される放射光をモニタ光として検出し、これに基づいてバイアス電圧を制御するフィードバック制御を行なうようにしている。

10

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述のように、モニタ光として放射光を用いる場合、放射光の強度は弱いため、光強度の検出に用いるモニタ用PDとして感度の高いものを用いる必要があり、モニタ用PDの選択の幅が狭い。また、モニタ用PDによって検出される信号の処理も制限されたものとなる。

20

【 0 0 0 5 】

このため、図18に示すように、MZ型光導波路110の出力側に例えば3dB方向性結合器111を設け、この3dB方向性結合器111の出力側の一のポートにモニタ用光導波路112を連結し、このモニタ用光導波路112を通じて導かれるモニタ光の強度を検出して、バイアス電圧のフィードバック制御に用いることも考えられる。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、このような方法でモニタ光を取り出すと、図19に示すように、モニタ光の強度が出力光（信号光）の強度と同じになってしまうため、入力光強度が大きい場合、モニタ光の強度としては大きすぎて、モニタ用PDが壊れてしまう可能性がある。

ところで、最近では、クロック信号による変調とデータ信号による変調とを直列に連結した2段のマッハツェンダ型光変調器によって行なって、RZ (Return to Zero)信号を生成するRZ光変調器が提案されている。

30

【 0 0 0 7 】

このようなRZ光変調器では、例えば図20（A），（B）に示すように、2段のマッハツェンダ型光変調器113，114のうち、後段に設けられるマッハツェンダ型光変調器114の出力側のY分岐光導波路115の分岐部分から放射される放射光のみをモニタ光としてモニタPD116によって検出して、これに基づいて、2段のマッハツェンダ型光変調器113，114の双方のバイアス制御を行なうことが考えられる。

【 0 0 0 8 】

しかしながら、このような方法では、正確なバイアス制御を行なうのは難しく、また、制御が複雑になる。本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、光検出部として採用しうる部品の選択の幅が広がるようにするとともに、モニタ光を正確、かつ確実に検出できるようにし、さらにバイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるようにした、光導波路デバイス及び光デバイスを提供することを目的とする。

40

【 0 0 0 9 】

また、バイアス制御を容易、かつ、正確に行なえるようにすることも目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

このため、請求項1記載の本発明の光導波路デバイスは、電気光学効果を有する長辺、短辺を有する基板と、基板上に長辺方向に並んで形成され、光学的に結合された第1、第

50

2のマッハツェンダ型干渉計と、基板の第1の短辺側に設けられた第1のマッハツェンダ型干渉計からの出力光の一部の放射である第1放射光に対応した位置に設けられた第1モニタ部と、基板の第2の短辺側に設けられた第2のマッハツェンダ型干渉計からの出力光の一部の放射である第2放射光に対応した位置に設けられた第2モニタ部と、を備え、基板は、第1モニタ部、第2モニタ部で検出可能な第1放射光、第2放射光とともに、第2の短辺を含む側面内から出力されるように、長辺の長さ、側面の前記第2の短辺以外の辺の長さが設定され、第1モニタ部と第2モニタ部を第2の短辺を含む側面側に設け、第1モニタ部と第2モニタ部は、基板の厚み方向にずらして配置された、ことを特徴としている。

【0014】

10

【発明の実施の形態】

以下、図面により、本発明の実施の形態について説明する。

(第1実施形態の説明)

まず、本発明の第1実施形態にかかる光導波路デバイスについて、図1～図10を参照しながら説明する。

【0015】

以下、本発明の光導波路デバイスを適用して構成される光変調器について、図1を参照しながら説明する。

本光変調器は、ニオブ酸リチウム(リチウムナイオベート, LiNbO_3 ; LN)を用いたマッハツェンダ型光変調器(MZ型LN光変調器)である。このような光変調器は例えば光送信機に備えられる。

20

【0016】

つまり、図1に示すように、本MZ型LN光変調器1は、ニオブ酸リチウム結晶を結晶方位のZ軸方向にカット(Z軸カット)して切り出されたニオブ酸リチウム結晶基板(LN基板)2上に、マッハツェンダ干渉計型(マッハツェンダ型)光導波路(MZ型光導波路)3Aを含む光導波路3を形成し、さらに、MZ型光導波路3Aの近傍に、データ信号(主信号)を入力する主電極4及びバイアス電圧を印加するバイアス電極5を形成したものと構成される。

【0017】

なお、ここでは、基板2としてニオブ酸リチウム結晶を用いているが、基板2は電気光学効果を有するものであれば良く、例えばタンタル酸リチウム(LiTaO_2 ; LT)結晶等の他の強誘電体結晶を用いることもできる。

30

ここで、 LiNbO_3 結晶や LiTaO_2 結晶などの電気光学効果を有する基板を用いたMZ型LN光変調器1は、例えば LiNbO_3 結晶や LiTaO_2 結晶等からなる基板上の一部に金属膜を形成し、熱拡散させて光導波路を形成するか、又は、金属膜をパターニングした後に、安息香酸中でプロトン交換するなどして光導波路を形成した後、光導波路の近傍に電極を設けることで形成される。

【0018】

具体的には、例えば、 LiNbO_3 結晶を基板に用いる場合、基板上にチタン膜(Ti膜)を所望の光導波路形状に合わせてパターニングし、このようにパターニングした状態で、1050℃で7～10時間加熱して熱拡散させることによって、光導波路を形成する。本実施形態では、光導波路3は、図1に示すように、入力側光導波路3aがY分岐光導波路(分岐光導波路)3bを介して分岐されて2つの平行な直線状光導波路3c, 3dに連結され、さらにこれらの直線状光導波路3c, 3dが3dBカプラ(導波路型カプラ)6を介してそれぞれ出力側光導波路3e及びモニタ用光導波路3fに連結されるように形成されている。なお、Y分岐光導波路3b, 直線状光導波路3c, 3d, 3dBカプラ6によってMZ型光導波路3Aが構成される。

40

【0019】

ここでは、3dBカプラ6は、導波路型の光カプラ(導波路型カプラ)として形成されている。この3dBカプラ6としては、例えば対称型のものが用いられ、一般的には導波路

50

型の方向性結合器型カプラ（3dB方向性結合器）が用いられる。より好ましくは、波長依存性の少なく、歩留まりの良い交差導波路型カプラ（3dB交差導波路型カプラ）を用いる。

【0020】

このように、本実施形態にかかる光変調器1は、1つのMZ型LN光変調器3Aと、1つの3dBカプラ6とを1チップ内に一体に集積化した構造となっている。

また、主電極4は、図1に示すように、一部がMZ型光導波路3Aを構成する一方の直線状光導波路3cと重なるように設けられた信号電極4aと、一部がMZ型光導波路3Aを構成する他方の直線状光導波路3dと重なるように設けられた接地電極4bとを備えるものとして構成される。この主電極4を構成する信号電極4aには、データ信号（主信号）を供給するデータ信号供給部（信号供給部）7が連結されている。

10

【0021】

そして、主電極4にデータ信号供給部7からデータ信号を供給して、直線状光導波路3c、3dにデータ信号に応じた電圧（データ信号電圧）を印加することで、直線状光導波路3c、3dに電界を生じさせて、直線状光導波路3c、3dの屈折率を変化させる。これにより、直線状光導波路3c、3dのそれぞれを伝播する光に位相差を生じさせ、これらの位相差の生じた光を3dBカプラ6で合波干渉させることで、出力側光導波路3eを介して、データ信号に応じて変調された出力光（変調信号）が出力されるようにしている。

【0022】

なお、本実施形態では、図1に示すように、信号電極4aの一方の端部（出力側端部、終端）と接地電極4bの一方の端部（出力側端部、終端）とを抵抗（終端器）で接続することで進行波電極とし、信号電極4aの他方の端部（入力側端部）と接地電極4bの他方の端部（入力側端部）とに接続されるデータ信号供給部7（電源回路や駆動回路を含む）を介してデータ信号としてのマイクロ波（マイクロ波信号、高周波、高周波信号）を供給して、これに応じた電圧が直線状光導波路3c、3dに印加されるようにしている。このように、本光変調器1は、高速で駆動することができるようになっている。

20

【0023】

特に、主電極4の断面形状を変えることで直線状光導波路3c、3dの実効屈折率を調節し、直線状光導波路3c、3dを伝播する光と、主電極4に供給されるマイクロ波の速度とを整合させることで、広帯域の光応答特性を得ることができるようになる。

30

また、バイアス電極5は、一部がMZ型光導波路3Aを構成する一方の直線状光導波路3cと重なるように設けられた電極5aと、一部がMZ型光導波路3Aを構成する他方の直線状導波路3dと重なるように設けられた接地電極5bとを備えるものとして構成される。このバイアス電極5には一般的にバイアス制御部（例えばバイアス制御回路）8が接続される。

【0024】

そして、バイアス電極5にバイアス制御部8を通じてバイアス電圧（DC電圧）を供給することで、光導波路3c、3dに対してバイアス電圧（DC電圧）が印加されるようになっている。

ここでは、後述するように、バイアス制御部8によって、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御するフィードバック制御を行なうことで、MZ型LN光変調器1の動作点電圧の変動を補償する。

40

【0025】

本実施形態では、Z軸カットのニオブ酸リチウム結晶基板2を用いており、Z軸方向の電界による屈折率変化を利用するため、主電極4、バイアス電極5は、直線状光導波路3c、3dの真上に形成される。

このように、本実施形態では、主電極4、バイアス電極5を、直線状光導波路3c、3dの真上にパターンニングするため、直線状光導波路3c、3d中を伝搬する光が各電極4、5によって吸収されてしまうおそれがある。これを防ぐために、本実施形態では、LN基板2と各電極4、5との間にバッファ層を形成している。このバッファ層は例えばSiO

50

膜として形成すれば良く、その厚さは、 $0.2 \sim 1 \mu\text{m}$ 程度とすれば良い。

【0026】

このため、本光変調器1は、主電極4及びバイアス電極5と基板2との間に、基板2の厚さと比べて厚さの薄いパツファ層を積層したものとして構成される。

なお、本実施形態では、主電極4、バイアス電極5は、いずれも1つの信号電極を有するシングル電極とし、光変調器1をシングル駆動型の光変調器として構成しているが、これに限られるものではない。例えば、駆動電圧を低減するためには、2つの信号電極を有するデュアル電極とし、デュアル駆動型の光変調器として構成すれば良い。

【0027】

ところで、本実施形態にかかる光変調器1では、図1に示すように、MZ型光導波路3Aの出力側には3dBカプラ6が設けられており、この3dBカプラ6の出力側の一のポートに出力側光導波路(信号用光導波路)3eが連結されている。

一方、本実施形態にかかる光変調器1では、図1に示すように、3dBカプラ6の出力側の他のポートにはモニタ用光導波路3fが連結されており、このモニタ用光導波路3fは、光変調器(チップ)1の出力端まで延びている。また、モニタ用光導波路3fには、後述するように、減衰部9が設けられている。そして、モニタ用光導波路3fの端部には、モニタPD(フォトディテクタ、バイアス制御用モニタPD、光検出部)10が設けられている。これにより、MZ型光変調器1で変調された出力光のうち、出力側光導波路3eの相補信号として、3dBカプラ6によってモニタ用光導波路3fに導かれ、減衰部9で減衰された後、モニタ光の強度がモニタPD10によって検出されるようになっている。

【0028】

また、図1に示すように、モニタPD10は、バイアス電圧の制御を行なうためのバイアス制御部8に接続されており、モニタPD10によって検出されたモニタ光の強度信号がバイアス制御部8へ送られるようになっている。そして、バイアス制御部8が、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧(DCバイアス電圧)を制御するフィードバック制御を行なうようになっている。つまり、バイアス制御部8は、モニタPD10によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。これにより、光変調器1の動作点電圧の変動が補償されることになる。

【0029】

ところで、上述のように、MZ型光導波路3Aの出力側に3dBカプラ6を設け、この3dBカプラ6に連結されるモニタ用光導波路3fを介してモニタ光を取り出す場合、モニタ光の強度が出力光(信号光)の強度と同じになってしまうため、モニタ光の強度としては大きすぎ、例えば入力光の強度が大きい場合には、モニタPD10に過大電流が流れてしまい、壊れてしまう場合がある。

【0030】

そこで、本実施形態では、モニタ光の強度を適正に調節できるようにすべく、図1に示すように、モニタ用光導波路3fに、モニタ光の出力(パワー)を減衰させる減衰部9が設けられている。これにより、減衰部9によってモニタ光の出力を減衰させ、モニタ光の出力をモニタPD10の感度に応じた適正なものにすることができるようになっている。このため、モニタPD10では、モニタ用光導波路3fを通じて導かれ、減衰部9によって減衰されたモニタ光の強度が検出されることになる。

【0031】

以下、減衰部9の具体的な構成例について、図2～図9を参照しながら説明する。

(1) 減衰部9を、図2に示すように、曲率半径を小さくした曲がり導波路9a(導波路型減衰器)によって構成する。

具体的には、図2に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、直線状光導波路3gよりも所望の大きさだけ曲率半径を小さくした曲がり導波路9aを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、曲がり導波路9aとからモニタ用光導波路3fが構成される。

10

20

30

40

50

【0032】

このように、モニタ用光導波路9を、曲率半径の小さい曲がり導波路9aによって構成すれば、モニタ用光導波路9をモニタ光が伝播する際に曲がり損が生じるため、モニタ用光導波路9を導かれるモニタ光の出力が減衰されることになる。

ここで、減衰部9を、曲率半径を小さくした曲がり導波路9aによって構成する場合、図2に示すように、曲がり導波路9aの端部から出射される導波光をモニタ光としてモニタPD10によって検出するようにしても良いし、図3に示すように、曲がり導波路9aの曲がった部分から放射される放射光をモニタ光としてモニタPD10によって検出するようにしても良い。

【0033】

特に、図2に示すように、曲がり導波路9aを通じて導かれる導波光をモニタ光として用いる場合には、モニタPD10は感度の低いものを用いることができ、コストを低く抑えることができるという利点がある。一方、図3に示すように、モニタ光として放射光を用いる場合には、モニタPD10は感度の高いものを用いる必要があるが、取り付けの際の位置合わせは容易であるという利点がある。

(2) 減衰部9を、図4に示すように、2つ以上の分岐光導波路(複数の分岐光導波路, 多分岐光導波路, 導波路型減衰器)9bによって構成する。

【0034】

具体的には、図4に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、2つ以上の分岐光導波路9bを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、2つ以上の分岐光導波路9bのうちの1つの分岐光導波路9baとからモニタ用光導波路3fが構成される。

【0035】

このように、モニタ用光導波路3fを、2つ以上の分岐光導波路9bを備えるものとして構成すれば、それぞれの分岐光導波路9bでモニタ光の一部が分岐されるため、モニタ用光導波路3fを構成する1つの分岐光導波路9baを導かれるモニタ光の出力が減衰されることになる。

(3) 減衰部9を、図5に示すように、1:Nの所定の分岐比で分岐する1:Nカプラ(導波路型カプラ, 導波路型減衰器)9cによって構成する。

【0036】

具体的には、図5に示すように、3dBカプラ6のポートから基板2の端面2Aへ向けて直線状に延びる光導波路3gを形成し、この直線状光導波路3gに連なるように、導波路型の1:Nカプラ(導波路型カプラ)9cを形成すれば良い。この場合、直線状光導波路3gと、1:Nカプラ9cの一方のポートに連なる光導波路9caとからモニタ用光導波路3fが構成される。

【0037】

このように、モニタ用光導波路3fを、1:Nカプラ9cを備えるものとして構成すれば、1:Nカプラ9cによってモニタ光の一部が分岐されるため、モニタ用光導波路3fを構成する1:Nカプラ9cの一方のポートに連なる光導波路9caを導かれるモニタ光の出力が減衰されることになる。

(4) 減衰部9を、図6, 図7に示すように、モニタ用光導波路3fの端部付近に設けられるビーム拡大部(導波路型減衰器)9dによって構成する。

【0038】

ここで、ビーム拡大部9dは、例えば図6に示すように、基板2の端面2A(又は、モニタ光を基板2の側面から出射させる場合は基板の側面)から所定距離の位置に形成されたモニタ用光導波路3fの端部によって構成すれば良い。なお、所定距離は、モニタPD10の感度などを考慮して設定すれば良い。ここでは、モニタPD10は基板2の端面2Aから離れた位置に設けているが、基板2の端面2Aに取り付けるようにしても良い。

【0039】

10

20

30

40

50

このように、ビーム拡大部 9 d を、モニタ用光導波路 3 f を途中で断線させることによって形成すれば、モニタ用光導波路 3 f の端部からモニタ光が放射され、基板 2 の端面 2 A から出射されるモニタ光のビーム径が大きくなり、モニタ光の出力が減衰されることになる。また、ビーム径が大きくなるため、モニタ P D 1 0 を設ける位置のトレランスを大きくすることもできる。

【 0 0 4 0 】

また、ビーム拡大部 9 d は、例えば図 7 に示すように、モニタ用光導波路 3 f の端部を 2 分岐させることによって構成しても良い。つまり、3 d B カプラ 6 のポートから基板 2 の端面 2 A へ向けて直線状に延びる光導波路 3 g を形成し、この直線状光導波路 3 g に連なるように、2 分岐光導波路 3 h を形成すれば良い。この場合、直線状光導波路 3 g と、2 分岐光導波路 3 h とからモニタ用光導波路 3 f が構成される。ここでは、モニタ P D 1 0 は基板 2 の端面 2 A から離れた位置に設けているが、基板 2 の端面 2 A に取り付けのようにしても良い。

10

【 0 0 4 1 】

このように、ビーム拡大部 9 d を、モニタ用光導波路 3 f の端部を 2 分岐させることによって構成すれば、モニタ光が 2 分岐光導波路 3 h で分岐され、分岐されたそれぞれの光導波路からモニタ光が出射されることになるため、モニタ光の出射領域が広がり、モニタ光の出力が減衰されることになる。また、モニタ光の出射領域が広がるため、モニタ P D 1 0 を設ける位置のトレランスを大きくすることもできる。

(5) 減衰部 9 を、上述の各減衰方法を任意に組み合わせたものとして構成する。

20

【 0 0 4 2 】

つまり、例えば図 8 に示すように、曲率半径を小さくした曲がり導波路 9 a を設けるとともに、モニタ用光導波路 3 f の端部を基板 2 の端面 2 A から所定距離の位置となるように途中で断線させるようにして、減衰部 9 を構成する。また、例えば図 9 に示すように、2 つ以上の分岐光導波路 9 b を設けるとともに、モニタ用光導波路 3 f の端部を基板 2 の端面 2 A から所定距離の位置となるように途中で断線させるようにして、減衰部 9 を構成する。このように、上述の各減衰方法を組み合わせることによって、モニタ光の出力が大きい場合であっても、確実に減衰させることができるようになる。

【 0 0 4 3 】

このように、光変調器 1 のモニタ用光導波路 3 f に減衰部 9 を設けると、図 1 0 に示すように、出力側光導波路 3 e から出射される出力光の出力よりもモニタ光の出力を低く抑えることができるようになる。

30

したがって、本実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器 1 によれば、マッハツェンダ型光導波路 3 A の出力側を 3 d B カプラ 6 とし、この 3 d B カプラ 6 の出力側の一のポートに連結される光導波路をモニタ用光導波路 3 f として、モニタ光を取り出す場合に、モニタ用光導波路 3 f に減衰器 9 が設けられているため、モニタ光の強度をモニタ P D 1 0 の感度に応じた適正な強度に調節することができる。

【 0 0 4 4 】

このため、本光導波路デバイス（光変調器）によれば、モニタ光を正確、かつ確実に検出でき、採用しうるモニタ P D 1 0 の選択の幅が広がり、また、バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるという利点がある。

40

なお、上述の実施形態では、本発明にかかる光導波路デバイスをマッハツェンダ型の光変調器 1 に適用しているが、これに限られるものではなく、例えば方向性結合器型光導波路を備える光変調器等の他の導波路構造の光変調器にも適用することができる。

【 0 0 4 5 】

また、上述の実施形態では、本発明にかかる光導波路デバイスを光変調器に適用した場合について説明したが、光導波路デバイスはこれに限られるものではなく、本発明は例えば光スイッチ等の他の光導波路デバイスに適用することができる。

また、上述の実施形態では、光変調器から出力される出力光の一部をモニタ光として取り出し、このモニタ光の強度を検出して、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうよう

50

にしているが、これに限られるものではなく、例えば、検出されたモニタ光の強度を、信号供給部（電源回路，駆動回路を含む）によって印加される電圧のフィードバック制御に用いるものであっても良い。

【0046】

さらに、上述の実施形態では、光変調器を主電極4とバイアス電極5とを備えるものとして構成しているが、これに限られるものではなく、例えば主電極4のみを備えるものとして構成し、主電極4に、データ信号を供給するとともに、バイアス電圧を印加するように構成しても良い。

（第2実施形態の説明）

次に、本発明の第2実施形態にかかる光導波路デバイスについて説明する。

10

【0047】

以下、本発明の光導波路デバイスを適用して構成されるRZ光変調器〔入力光に対してクロック信号とデータ信号を与えてRZ（Return to Zero）信号を生成する光変調器（クロック変調型光変調器）〕について、図11～図17を参照しながら説明する。

本実施形態にかかるRZ光変調器は、例えば長距離光伝送システムにおける光送信器として用いられる。

【0048】

本実施形態では、図11に示すように、RZ光変調器20は、ニオブ酸リチウム（リチウムナイオベート， LiNbO_3 ；LN）を用いた2段のマッハツェンダ型光変調器（MZ型LN光変調器）21，41を備えるものとして構成される。

20

つまり、RZ光変調器20は、図11に示すように、ニオブ酸リチウム結晶を結晶方位のZ軸方向にカット（Z軸カット）して切り出されたニオブ酸リチウム結晶基板（LN基板）22上に、マッハツェンダ型の第1光導波路（以下、第1光導波路という）23，マッハツェンダ型の第2光導波路（以下、第2光導波路という）24を含む光導波路を形成し、さらに、第1光導波路23の近傍に第1電極（主電極）25及び第1バイアス電極26を形成し、第2光導波路24の近傍に第2電極（主電極）27及び第2バイアス電極28を形成したものと構成される。

【0049】

なお、RZ光変調器20の前段側に設けられる第1光導波路23，第1電極25，第1バイアス電極26を備えるものとして、マッハツェンダ型の第1光変調器21（クロック信号に変調するため、クロック変調器ともいう）が構成され、RZ光変調器20の後段側に設けられる第2光導波路24，第2電極27，第2バイアス電極28を備えるものとして、マッハツェンダ型の第2光変調器（NRZ（Non Return to Zero）信号に変調するため、NRZ変調器ともいう）41が構成される。

30

【0050】

なお、ここでは、基板としてニオブ酸リチウム結晶を用いているが、基板は電気光学効果を有するものであれば良く、例えばタンタル酸リチウム（ LiTaO_2 ；LT）結晶等の他の強誘電体結晶を用いることもできる。

ここで、 LiNbO_3 結晶や LiTaO_2 結晶などの電気光学効果を有する基板を用いたRZ光変調器1は、例えば LiNbO_3 結晶や LiTaO_2 結晶等からなる基板上の一部に金属膜を形成し、熱拡散させて光導波路を形成するか、又は、金属膜をパターンニングした後、安息香酸中でプロトン交換するなどして光導波路を形成した後、光導波路の近傍に電極を設けることで形成される。

40

【0051】

具体的には、例えば、 LiNbO_3 結晶を基板に用いる場合、基板上にチタン膜（Ti膜）を所望の光導波路形状に合わせてパターンニングし、このようにパターンニングした状態で、1050で7～10時間加熱して熱拡散させることによって、光導波路を形成する。本実施形態では、光導波路は、図11に示すように、入力側光導波路30が対称型の3dBカプラ（光カプラ，導波路型カプラ）29aを介して分岐されて2つの平行な直線状光導波路23b，23cに連結され、さらにこれらの直線状光導波路23b，23cが対称

50

型の 3 d B カプラ（光カプラ，導波路型カプラ）2 9 b を介してそれぞれ中間光導波路 3 1 及びモニタ用光導波路 2 3 d に連結されるように形成されている。ここでは、3 d B カプラ 2 9 a，2 9 b は同じ形のものを用いている。なお、3 d B カプラ 2 9 a，直線状光導波路 2 3 b，2 3 c，3 d B カプラ 2 9 b によってマッハツェンダ型の第 1 光導波路 2 3 が構成される。

【0052】

また、図 1 1 に示すように、中間光導波路 3 1 が Y 分岐光導波路（分岐光導波路）2 4 a を介して分岐されて 2 つの平行な直線状光導波路 2 4 b，2 4 c に連結され、さらにこれらの直線状光導波路 2 4 b，2 4 c が対称型の 3 d B カプラ（光カプラ，導波路型カプラ）2 9 c を介してそれぞれ出力側光導波路 3 2 及びモニタ用光導波路 2 4 d に連結されるように形成されている。なお、Y 分岐光導波路 2 4 a，直線状光導波路 2 4 b，2 4 c，3 d B カプラ 2 9 c によってマッハツェンダ型の第 2 光導波路 2 4 が構成される。

10

【0053】

ここでは、第 1 光導波路 2 3 及び第 2 光導波路 2 4 を構成する 3 d B カプラ 2 9 a ~ 2 9 c は、導波路型の光カプラ（導波路型カプラ）として形成されている。この 3 d B カプラ 2 9 a ~ 2 9 c としては、一般的には方向性結合器型カプラ（3 d B 方向性結合器）が用いられるが、より好ましくは、波長依存性の少なく、歩留まりの良い交差導波路型カプラ（3 d B 交差導波路型カプラ）を用いる。

【0054】

このように、本実施形態の R Z 光変調器 2 0 は、2 つの M Z 型 L N 光変調器 2 1，4 1 と、3 つの 3 d B カプラ 2 9 a ~ 2 9 c とを 1 チップ内に一体に集積化した構造となっている。

20

また、第 1 電極 2 5 は、図 1 1 に示すように、一部が第 1 光導波路 2 3 を構成する一方の直線状光導波路 2 3 b と重なるように設けられた信号電極 2 5 a と、一部が第 1 光導波路 2 3 を構成する他方の直線状光導波路 2 3 c と重なるように設けられた接地電極 2 5 b とを備えるものとして構成される。この第 1 電極 2 5 を構成する信号電極 2 5 a には、例えば 2 0 G H z の周波数の正弦波電気信号（マイクロ波信号，高周波信号）をクロック信号として供給するクロック信号供給部（信号供給部）3 3 が接続されている。

【0055】

そして、第 1 電極 2 5 にクロック信号供給部 3 3 からクロック信号を供給して、直線状光導波路 2 3 b，2 3 c にクロック信号に応じた電圧（クロック信号電圧，信号電圧）を印加することで、直線状光導波路 2 3 b，2 3 c に電界を生じさせて、直線状光導波路 2 3 b，2 3 c の屈折率を $+n$ ， $-n$ のように変化させる。これにより、直線状光導波路 2 3 b，2 3 c のそれぞれを伝播する光に位相差を生じさせ、これらの位相差の生じた光を 3 d B カプラ 2 9 b で合波干渉させることで、中間光導波路 3 1 を介して、第 2 光導波路 2 4 へ向けて、例えば 4 0 G H z の光クロック信号 [即ち、「1」，「1」，「1」，... のデータ配列の 4 0 G b / s の R Z データ信号（光 R Z 信号）に変調された変調信号] が出力されるようにしている。

30

【0056】

なお、本実施形態では、信号電極 2 5 a の一方の端部（出力側端部，終端）と接地電極 2 5 b の一方の端部（出力側端部，終端）とを抵抗（終端器）で接続することで進行波電極とし、信号電極 2 5 a の他方の端部（入力側端部）と接地電極 2 5 b の他方の端部（入力側端部）とに接続されるクロック信号供給部 3 3（電源回路や駆動回路を含む）を介してクロック信号を供給して、これに応じた電圧が直線状光導波路 2 3 b，2 3 c に印加されるようにしている。このように、第 1 光変調器 2 1 は、高速で駆動することができるようになっている。

40

【0057】

特に、第 1 電極 2 5 の断面形状を変えることで直線状光導波路 2 3 b，2 3 c の実効屈折率を制御し、直線状光導波路 2 3 b，2 3 c を伝播する光と、第 1 電極 2 5 に供給されるマイクロ波の速度とを整合させることで、広帯域の光応答特性を得ることができるよう

50

なる。

同様に、第2電極27も、図11に示すように、一部が第2光導波路24を構成する一方の直線状光導波路24bと重なるように設けられた信号電極27aと、一部が第2光導波路24を構成する他方の直線状光導波路24cと重なるように設けられた接地電極27bとを備えるものとして構成される。この第2電極27を構成する信号電極27aには、第1光変調器21からの例えば40GHzの光クロック信号に同期したタイミングで、例えば40Gb/sのNRZデータ信号（電気信号）を供給するNRZデータ信号供給部（信号供給部）34が接続されている。

【0058】

そして、第2電極27にNRZデータ信号供給部34からNRZデータ信号を供給して、直線状光導波路24b、24cにNRZデータ信号に応じた電圧（NRZデータ信号電圧、信号電圧）を印加することで、直線状光導波路24b、24cに電界を生じさせて、直線状光導波路24b、24cの屈折率を $+m$ 、 $-m$ のように変化させる。これにより、直線状光導波路24b、24cのそれぞれを伝播する光に位相差を生じさせ、これらの位相差の生じた光を3dBコプラ29cで合波干渉させることで、出力側光導波路32を介して、例えば40Gb/sの光RZデータ信号（変調信号）が出力されるようにしている。

【0059】

なお、本実施形態では、信号電極27aの一方の端部（出力側端部、終端）と接地電極27bの一方の端部（出力側端部、終端）とを抵抗（終端器）で接続することで進行波電極とし、信号電極27aの他方の端部（入力側端部）と接地電極27bの他方の端部（入力側端部）とに接続されるNRZデータ信号供給部34（電源回路や駆動回路を含む）を介してNRZデータ信号を供給して、これに応じた電圧が直線状光導波路24b、24cに印加されるようにしている。このように、第2光変調器41は、高速で駆動することができるようになっている。

【0060】

特に、第2電極27の断面形状を変えることで直線状光導波路24b、24cの実効屈折率を制御し、直線状光導波路24b、24cを伝播する光と、第2電極27に供給されるマイクロ波の速度とを整合させることで、広帯域の光応答特性を得ることができるようになる。

また、第1バイアス電極26は、図11に示すように、一部が第1光導波路23を構成する一方の直線状導波路23bと重なるように設けられた電極26aと、一部が第1光導波路23を構成する他方の直線状導波路23cと重なるように設けられた接地電極26bとを備えるものとして構成される。この第1バイアス電極26には第1バイアス制御部（例えばバイアス制御回路）35が接続されている。

【0061】

そして、第1バイアス電極26に第1バイアス制御部35を通じてバイアス電圧（DC電圧）を供給することで、第1光導波路23に対してバイアス電圧（DC電圧）が印加されるようになっている。

ここでは、後述するように、第1バイアス制御部35によって、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御するフィードバック制御を行なうことで、第1光変調器21の動作点電圧の変動を補償している。

【0062】

同様に、第2バイアス電極28は、図11に示すように、一部が第2光導波路24を構成する一方の直線状導波路24bと重なるように設けられた電極28aと、一部が第2光導波路24を構成する他方の直線状導波路24cと重なるように設けられた接地電極28bとを備えるものとして構成される。この第2バイアス電極28には第2バイアス制御部（バイアス制御回路）36が接続されている。

【0063】

そして、第2バイアス電極28に第2バイアス制御部36を通じてバイアス電圧（DC電

10

20

30

40

50

圧)を供給することで、第2光導波路24に対してバイアス電圧(DC電圧)が印加されるようになっている。

ここでは、後述するように、第2バイアス制御部36によって、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧を制御するフィードバック制御を行なうすることで、第2光変調器41の動作点電圧の変動を補償している。

【0064】

本実施形態では、Z軸カットのニオブ酸リチウム結晶基板22を用いており、Z軸方向の電界による屈折率変化を利用するため、第1電極25、第1バイアス電極26は、第1光導波路23の直線状導波路23b、23cの真上に形成され、第2電極27、第2バイアス電極28は第2光導波路24の直線状導波路24b、24cの真上に形成される。

10

【0065】

このように、本実施形態では、第1電極25、第1バイアス電極26、第2電極27、第2バイアス電極28は、直線状導波路23b、23c、24b、24cの真上にパターンニングするため、直線状光導波路23b、23c、24b、24c中を伝搬する光が各電極25、26、27、28によって吸収されてしまうおそれがある。これを防ぐために、本実施形態では、LN基板22と各電極25、26、27、28との間にバッファ層を形成している。このバッファ層は例えばSiO₂膜として形成すれば良く、その厚さは、0.2~1μm程度とすれば良い。

【0066】

このため、本RZ光変調器20は、第1、第2電極25、27及び第1、第2バイアス電極26、28と基板22との間に、基板22の厚さと比べて厚さの薄いバッファ層を積層したものとして構成される。

20

なお、本実施形態では、第1電極25、第2電極27、第1バイアス電極26、第2バイアス電極28は、いずれも1つの信号電極を有するシングル電極とし、RZ光変調器20をシングル駆動型の光変調器として構成しているが、これに限られるものではない。例えば、駆動電圧を低減するためには、2つの信号電極を有するデュアル電極とし、デュアル駆動型の光変調器として構成すれば良い。

【0067】

ところで、本実施形態では、図11に示すように、第1光導波路23の出力側には3dBカプラ29bが設けられており、この3dBカプラ29bの出力側の一のポートに中間光導波路31を介して第2光導波路24の入力側、即ち、第2光導波路24のY分岐光導波路24aが連結されている。つまり、第1光変調器21と第2光変調器41とは、光導波方向に沿って直列に連結されている。

30

【0068】

なお、ここでは、前後に2つの光変調器21、41を直列に連結しているが、光変調器の数はこれに限られるものではない。つまり、複数の光変調器を直列に連結しても良い。この場合、モニタPD、信号供給部も複数設けることになる。

これにより、図示しない光源(半導体レーザ)からの入力光が、入力側光導波路30、3dBカプラ29aを介して第1光導波路23に導入され、この第1光導波路23を伝播する際に所望のクロック信号(電気信号)に基づいて変調された後、第1光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29b及び3dBカプラ29bの出力側の一のポートに連結されている中間光導波路31を介して第2光導波路24へ導かれ、さらに第2光導波路24でNRZデータ信号(電気信号)に基づいて変調され、3dBカプラ29c及び3dBカプラ29cの出力側の一のポートに連結されている出力側光導波路32を介して、変調された出力光(信号光、光NR信号)が出力されるようになっている。

40

【0069】

本実施形態では、図11に示すように、第1光導波路23の出力側に設けられる3dBカプラ29bの他のポートには第1モニタ用光導波路23dが連結されており、この第1モニタ用光導波路23dは、RZ光変調器(チップ)20の出力端まで延びている。そして、第1モニタ用光導波路23dの端部には、第1モニタPD(フォトディテクタ、第1バ

50

イアス制御用モニタPD, 光検出部, 光検出器) 37が設けられている。これにより、第1光変調器21で変調された光の一部が、3dBカプラ29bによってモニタ光として分岐されて第1モニタ用光導波路23dに導かれ、モニタ光の強度が第1モニタPD37によって検出されるようになっている。

【0070】

また、図11に示すように、第1モニタPD37は、バイアス電圧の制御を行なうための第1バイアス制御部35に接続されており、第1モニタPD37によって検出されたモニタ光の強度信号が第1バイアス制御部35へ送られるようになっている。そして、第1バイアス制御部35が、モニタ光の強度に基づいてバイアス電圧(DCバイアス電圧)を制御するフィードバック制御を行なうようになっている。つまり、第1バイアス制御部35は、第1モニタPD37によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。これにより、第1光変調器21の動作点電圧の変動が補償されることになる。

10

【0071】

一方、第2光導波路24の出力側に設けられる3dBカプラ29cの他のポートには第2モニタ用光導波路24dが連結されており、この第2モニタ用光導波路24dは、RZ光変調器(チップ)20の出力端まで延びている。そして、第2モニタ用光導波路24dの端部には、第2モニタPD(フォトディテクタ, 第2バイアス制御用モニタPD, 光検出部, 光検出器)38が設けられている。これにより、第2光変調器41で変調された光の一部が、3dBカプラ29cによってモニタ光として分岐されて第2モニタ用光導波路24dに導かれ、モニタ光の強度が第2モニタPD38によって検出されるようになっている。

20

【0072】

また、図11に示すように、第2モニタPD38は、バイアス電圧の制御を行なうための第2バイアス制御部36に接続されており、第2モニタPD38によって検出されたモニタ光の強度信号が第2バイアス制御部36へ送られるようになっている。そして、第2バイアス制御部36が、モニタ光の強度に基づいて、バイアス電圧(DCバイアス電圧)のフィードバック制御を行なうようになっている。つまり、第2バイアス制御部36は、第2モニタPD38によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。これにより、第2光変調器41の動作点電圧の変動が補償されることになる。

30

【0073】

このように、本実施形態では、第1光変調器21によって変調された光(信号光)の一部をモニタ光として取り出し、このモニタ光の強度を第1モニタPD37で検出するとともに、これとは独立に、第2光変調器41によって変調された光(信号光)の一部をモニタ光として取り出し、このモニタ光の強度を第2モニタPD38によって検出するようにしている。

【0074】

そして、第1モニタPD37と、第2モニタPD38とを、それぞれ別個のバイアス制御部35, 36に接続している。つまり、第1モニタPD37は、第1光変調器21のバイアス制御を行なうための第1バイアス制御部35に接続し、第2モニタPD38は、第2光変調器41のバイアス制御を行なうための第2バイアス制御部36に接続している。

40

【0075】

これにより、第1光変調器21の動作点電圧の変動を補償するために行なわれるバイアス電圧のフィードバック制御と、第2光変調器41の動作点電圧の変動を補償するために行なわれるバイアス電圧のフィードバック制御とが、それぞれ独立して行なわれるようにしている。

したがって、本実施形態にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器20によれば、それぞれの光変調器21, 41毎に設けられた第1モニタPD37, 第2モニタPD38によって、各光変調器21, 41によって変調された光をそれぞれ独立にモニタするため

50

、それぞれの光変調器 2 1 , 4 1 のバイアス制御が容易、かつ、正確に行なえるようになるという利点がある。

【 0 0 7 6 】

なお、本第 2 実施形態では、第 1 光変調器 2 1 及び第 2 光変調器 4 1 は、いずれもマッハツェンダ型の光変調器として構成しているが、これに限られるものではなく、例えば方向性結合器型の光変調器として構成しても良い。

また、本第 2 実施形態では、第 2 光変調器 2 1 の入力側を Y 分岐光導波路 2 4 a としているが、これに限られるものではなく、例えば 3 d B カプラとして構成しても良い。

【 0 0 7 7 】

さらに、本第 2 実施形態では、第 1 光変調器 2 1 の入射側及び出射側に 3 d B カプラ 2 9 a , 2 9 b を設けており、さらに、第 2 光変調器 4 1 の出射側にも 3 d B カプラ 2 9 c を設けているが、これに限られるものではなく、例えば Y 分岐光導波路として構成しても良い。

(第 2 実施形態の第 1 変形例の説明)

次に、本発明の第 2 実施形態の第 1 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器について、図 1 2 を参照しながら説明する。

【 0 0 7 8 】

本第 1 変形例にかかる R Z 光変調器は、上述の第 2 実施形態のものとは比べ、第 1 光導波路 2 3 の出力側に設けられる 3 d B カプラ 2 9 b に連結される第 1 モニタ用光導波路の構成と、第 1 光変調器 2 1 のバイアス制御に用いられる第 1 モニタ P D 3 7 を設ける位置が異なる。

つまり、本第 1 変形例では、図 1 2 に示すように、第 1 光導波路 2 3 の出力側に設けられる 3 d B カプラ 2 9 b の出力側の他のポートに連結される第 1 モニタ用光導波路 2 3 d を、R Z 光変調器 5 0 (チップ) の側面まで延びるように形成し、この R Z 光変調器 5 0 の側面まで延びる第 1 モニタ用光導波路 2 3 d の端部に第 1 モニタ P D (光検出部) 3 7 を設けている。

【 0 0 7 9 】

なお、その他の構成は上述の第 2 実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

このように、本第 1 変形例によれば、上述の第 2 実施形態の構成による効果に加え、第 1 モニタ P D 3 7 を R Z 光変調器 2 0 の側面に設けることができるため、第 1 モニタ P D 3 7 , 第 2 モニタ P D 3 8 の配設位置の自由度が大きくなるという利点がある。

(第 2 実施形態の第 2 変形例の説明)

次に、本発明の第 2 実施形態の第 2 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器について、図 1 3 を参照しながら説明する。

【 0 0 8 0 】

本第 2 変形例にかかる R Z 光変調器は、上述の第 2 実施形態のものとは比べ、第 2 光変調器 4 1 から出力される光のモニタ方法が異なる。このため、第 2 光導波路 2 4 の出力側の構成が異なり、また、第 2 光導波路 2 4 のバイアス制御に用いられる第 2 モニタ P D (光検出部) 3 8 を設ける位置が異なる。

つまり、図 1 3 に示すように、本第 2 変形例にかかる R Z 光変調器 6 0 では、第 2 光導波路 2 4 の出力側を Y 分岐光導波路 6 1 とし、この Y 分岐光導波路 6 1 を出力側光導波路 3 2 に連結して、第 2 光導波路 2 4 からの出力光が Y 分岐光導波路 6 1 , 出力側光導波路 3 2 を介して出力されるようにしている。そして、O F F 状態に Y 分岐光導波路 6 1 の分岐部分から放射される放射光をモニタ光として用いるようにしている。このため、第 2 モニタ P D 3 8 は、R Z 光変調器 (チップ) 6 0 の出力側の端面であって、Y 分岐光導波路 6 1 の分岐部分からの放射光の強度を検出できるような位置に設けている。

【 0 0 8 1 】

なお、その他の構成は上述の第 2 実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

10

20

30

40

50

このように、本第2変形例によれば、上述の第2実施形態の構成による効果に加え、第2モニタPD38の配設位置のトレランスを大きくすることができる。

(第2実施形態の第3変形例の説明)

次に、本発明の第2実施形態の第3変形例にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器について、図14(A)、(B)を参照しながら説明する。なお、図14(A)は模式的平面図であり、図14(B)は模式的断面図である。

【0082】

本第3変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものとは比べ、第1光変調器21及び第2光変調器41から出力される光のモニタ方法が異なる。このため、第1光導波路23及び第2光導波路24の出力側の構成が異なり、また、第1光導波路23のバイ

10

【0083】

つまり、図14(A)、(B)に示すように、本第3変形例にかかるRZ光変調器70では、第1光導波路23の出力側をY分岐光導波路71とし、このY分岐光導波路71を中間光導波路31を介して第2光導波路24に連結して、第1光導波路23からの出力光がY分岐光導波路71、中間光導波路31を介して第2光導波路24へ向けて出力されるようにしている。そして、OFF状態にY分岐光導波路71の分岐部分から放射される放射光をモニタ光として用いるようにしている。このため、第1モニタPD37は、RZ光変調器(チップ)70の出力側の端面であって、Y分岐光導波路71の分岐部分からの放射

20

【0084】

また、図14(A)、(B)に示すように、第2光導波路24の出力側をY分岐光導波路72とし、このY分岐光導波路72を出力側光導波路32に連結して、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波路72、出力側光導波路32を介して出力されるようにしている。そして、OFF状態にY分岐光導波路72の分岐部分から放射される放射光をモニタ光として用いるようにしている。このため、第2モニタPD38は、RZ光変調器(チップ)70の出力側の端面であって、Y分岐光導波路72の分岐部分からの放射光の強度を検出できるような位置に設けている。

【0085】

30

特に、図14(B)に示すように、OFF状態に第1光導波路23のY分岐光導波路71の分岐部分から放射される放射光は、RZ光変調器(チップ)70の厚さ方向に向けて斜めにチップ表面から離れていくように伝播するため、RZ光変調器70の出力側の端面において、基板22の底面に近い位置から出射することになる。このため、第1モニタPD37は、RZ光変調器70の出力側の端面の基板22の底面に近い位置に設けることになる。なお、第1モニタPD37の配設位置は、第1光導波路23のY分岐光導波路71の分岐部分の位置からRZ光変調器70の出力側の端面までの距離に応じて決められる。

【0086】

一方、図14(B)に示すように、OFF状態に第2光導波路24のY分岐光導波路72の分岐部分から放射される放射光は、Y分岐光導波路72の分岐部分からRZ光変調器(チップ)70の出力側の端面までの距離が近いため、RZ光変調器70の出力側の端面において、基板22の表面に近い位置から出射することになる。このため、第2モニタPD38は、RZ光変調器70の出力側の端面において、基板22の表面に近い位置に設けることになる。なお、第2モニタPD38の配設位置は、第2光導波路24のY分岐光導波路72の分岐部分の位置からRZ光変調器70の出力側の端面までの距離に応じて決められる。

40

【0087】

このように、RZ光変調器70の出力側の端面において、基板22の表面に近い方の位置に第2モニタPD38が設けられ、第2モニタPD38よりも基板22の表面から離れた位置(即ち、基板の底面に近い位置)に第1モニタPD37が設けられることになる。つ

50

まり、2つのモニタPD37, 38は、対応するY分岐光導波路71, 72の分岐部分から放射される放射光の強度を検出するように、基板22の出力側端面の厚さ方向に位置をずらして配設されている。

【0088】

なお、本第3変形例では、第1光導波路23の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本第3変形例では、第1光導波路23の入力側をY分岐光導波路73とし、このY分岐光導波路73を介して入力側光導波路30を第1光導波路23に連結するようにしている。なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0089】

このように、本第3変形例によれば、上述の第2実施形態の構成による効果に加え、第2モニタPD38の配設位置のトレランスを大きくすることができる。また、モニタ光を取り出すのにモニタ用光導波路を形成する必要がないため、RZ光変調器70の全体の大きさをコンパクトにすることができる。

(第2実施形態の第4変形例の説明)

次に、本発明の第2実施形態の第4変形例にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器について、図15を参照しながら説明する。

【0090】

本第4変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものと比べ、第1光変調器23の出力側の構成及び第2光変調器24の出力側の構成が異なる。つまり、図15に示すように、本第4変形例にかかるRZ光変調器80では、第1光導波路23の出力側をY分岐光導波路81とし、このY分岐光導波路81に、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ, 導波路型カプラ)82を連結している。そして、1:Nカプラ82の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)80の出力側の端面まで延びるように形成されている第1モニタ用光導波路23dが連結されており、この第1モニタ用光導波路23dの端部に第1モニタPD(光検出部)37が配設されている。

【0091】

一方、図15に示すように、1:Nカプラ82の他のポート(出力の大きい方)には、第2光導波路24の入力側のY分岐光導波路24aが連結されており、第1光導波路23からの出力光がY分岐光導波路81, 1:Nカプラ82を介して第2光導波路24へ向けて出力されるようにしている。

また、図15に示すように、第2光導波路24の出力側もY分岐光導波路83とし、このY分岐光導波路83に、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ, 導波路型カプラ)84を連結している。そして、1:Nカプラ84の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)80の出力側の端面まで延びるように形成されている第2モニタ用光導波路24dが連結されており、この第2モニタ用光導波路24dの端部に第2モニタPD(光検出部)38が配設されている。

【0092】

一方、図15に示すように、1:Nカプラ84の他のポート(出力の大きい方)には、出力側光導波路32が連結されており、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波路83, 1:Nカプラ84, 出力側光導波路32を介して出力されるようにしている。

なお、本第4変形例では、第1光導波路23の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本第4変形例では、第1光導波路23の入力側をY分岐光導波路85とし、このY分岐光導波路85を介して入力側光導波路30を第1光導波路23に連結するようにしている。なお、その他の構成は上述の第2実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【0093】

このように、本第4変形例によれば、出力光は1:Nの比率で弱くなるため、1:Nカプラの分岐比を適切に設計することにより、分岐後のモニタ光導波路23d, 24dを伝播

10

20

30

40

50

するモニタ光を減衰させるために導波路形状を工夫する必要がなく、導波路構造の設計が容易であるという利点がある。

(第2実施形態の第5変形例の説明)

次に、本発明の第2実施形態の第5変形例にかかる光導波路デバイスとしてのRZ光変調器について、図16を参照しながら説明する。

【0094】

本第5変形例にかかるRZ光変調器は、上述の第2実施形態のものとは比べ、第1光変調器21の出力側の構成及び第2光変調器41の出力側の構成が異なり、さらに、第2光変調器41の後段に、3段目のマッハツェンダ型光変調器として、マッハツェンダ型の可変減衰器が設けられている点異なる。このようなRZ光変調器を可変減衰器集積型RZ光変調器という。

10

【0095】

つまり、図16に示すように、本第5変形例にかかるRZ光変調器90では、第1光導波路23の出力側をY分岐光導波路91とし、このY分岐光導波路91に、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)92を連結している。そして、1:Nカプラ92の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第1モニタ用光導波路23dが連結されており、この第1モニタ用光導波路23dの端部に第1モニタPD(光検出部)37が配設されている。

【0096】

20

一方、図16に示すように、1:Nカプラ92の他のポート(出力の大きい方)には、第2光導波路24の入力側のY分岐光導波路24aが連結されており、第1光導波路23からの出力光がY分岐光導波路91,1:Nカプラ92を介して第2光導波路24へ向けて出力されるようにしている。

また、図16に示すように、第2光導波路24の出力側もY分岐光導波路93とし、このY分岐光導波路93に、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)94を連結している。そして、1:Nカプラ94の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第2モニタ用光導波路24dが連結されており、この第2モニタ用光導波路24dの端部に第2モニタPD(光検出部)38が配設されている。

30

【0097】

一方、1:Nカプラ94の他のポート(出力の大きい方)には、図16に示すように、マッハツェンダ型の可変減衰器95が連結されている。つまり、第2光変調器41の後段には、マッハツェンダ型の可変減衰器95が連結されている。このため、可変減衰器95には、第2光導波路24からの出力光がY分岐光導波路93,1:Nカプラ94を介して入力されるようになっている。

【0098】

ここで、可変減衰器95は、図16に示すように、入力側のY分岐光導波路96a,2つの平行な直線状光導波路96b,96c,出力側のY分岐光導波路96dを備えるマッハツェンダ型の光導波路96と、電極97と、バイアス電極98とを備えるものとして構成される。そして、電極97を介して直線状光導波路96b,96cに所定の直流電圧(DC電圧)を印加して、直線状光導波路96b,96cの屈折率を変化させることで、直線状光導波路96b,96cの透過率を変化させ、直線状光導波路96b,96c内を伝播する光(信号光)の出力(パワー)を減衰させるようになっている。このため、電極97には電圧供給部(電源回路や駆動回路を含む)が接続されている。

40

【0099】

また、可変減衰器95の出力側のY分岐光導波路96dには、1:Nの所定の分岐比で分岐する導波路型の1:Nカプラ(例えば1:10カプラ,導波路型カプラ)99が連結されている。この1:Nカプラ99の一のポート(出力の小さい方)には、RZ光変調器(チップ)90の出力側の端面まで延びるように形成されている第3モニタ用光導波路10

50

0 が連結されており、この第 3 モニタ用光導波路 100 の端部に第 3 モニタ P D (光検出部) 101 が配設されている。

【 0100 】

そして、第 3 モニタ P D 101 によって検出されたモニタ光の強度に基づいて、バイアス電圧 (D C バイアス電圧) のフィードバック制御が行なわれるようになっている。つまり、第 2 モニタ P D 101 によって検出された検出値が目標値に近づくように、バイアス電圧のフィードバック制御を行なうようになっている。このため、第 2 モニタ P D 101 には第 3 バイアス制御部 (バイアス制御回路) が接続されている。

【 0101 】

このように、電極 97 に所定の D C 電圧を印加するとともに、任意に設定しうる目標値に近づくようにバイアス電圧を印加することで、直線状光導波路 96b, 96c に印加される D C 電圧を可変制御して、出力光のパワーを調節できるようにしている。

一方、図 16 に示すように、1 : N カプラ 99 の他のポート (出力の大きい方) には、出力側光導波路 32 が連結されており、可変減衰器 95 からの出力光が 1 : N カプラ 99, 出力側光導波路 32 を介して出力されるようにしている。

【 0102 】

なお、本第 5 変形例では、第 1 光導波路 23 の入力側の構成も異なるものとしている。つまり、本第 5 変形例では、第 1 光導波路 23 の入力側を Y 分岐光導波路 102 とし、この Y 分岐光導波路 102 を介して入力側光導波路 30 を第 1 光導波路 23 に連結するようにしている。なお、その他の構成は上述の第 2 実施形態のものと同様であるため、ここでは説明を省略する。

【 0103 】

このように、本第 5 変形例によれば、上述の第 4 変形例の場合と同様に、出力光は 1 : N の比率で弱くなるため、1 : N カプラの分岐比を適切に設計することにより、分岐後のモニタ光導波路 23d, 24d を伝播するモニタ光を減衰させるために導波路形状を工夫する必要がなく、導波路構造の設計が容易であるという利点がある。

【 0104 】

なお、図 17 に示すように、上述の第 2 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器 20 のモニタ用光導波路 23d, 24d に、上述の第 1 実施形態のモニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる減衰部 9 を設けるのも好ましい。これにより、上述の第 2 実施形態及びその各変形例の構成における効果に加え、モニタ光を正確、かつ確実に検出でき、採用しうるモニタ P D 10 の選択の幅が広がり、また、バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるようになる。なお、第 2 実施形態の各変形例において、モニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる必要がある場合には、同様にモニタ用光導波路に減衰部 9 を設ければよい。

【 0105 】

なお、上述の各実施形態及び各変形例では、モニタ用光導波路を通じてモニタ光を取り出す場合にモニタ用 P D を基板の端面に取り付けるようにしているものがあるが、これに限られるものではなく、モニタ用光導波路を導かれるモニタ光の強度に応じて、基板の端面から所定距離だけ離れた位置 (例えば筐体) に取り付けるとしても良い。

[付記]

(付記 1) 電気光学効果を有する基板と、
前記基板上に直列に形成される複数のマッハツェンダ型又は方向性結合器型の光導波路と、
前記複数の光導波路毎に独立して設けられる複数の電極と、
前記複数の光導波路から出射される光の強度をそれぞれ独立して検出する複数の光検出部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【 0106 】

(付記 2) 前記複数の光導波路のそれぞれの出力側に設けられる複数の導波路型カプラと、

10

20

30

40

50

前記複数の導波路型カブラの一方のポートに連結される複数のモニタ用光導波路とを備え、
前記複数の光検出部が、それぞれ対応するモニタ用光導波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出することを特徴とする、付記 1 記載の光導波路デバイス。

【 0 1 0 7 】

(付記 3) 前記導波路型カブラが 3 d B カブラであり、
前記モニタ用光導波路が、前記 3 d B カブラの一方のポートに連結されることを特徴とする、付記 2 記載の光導波路デバイス。

(付記 4) 前記導波路型カブラが 1 : N カブラであり、
前記モニタ用光導波路が、前記 1 : N カブラの一方のポートに連結されることを特徴とする、付記 2 記載の光導波路デバイス。

10

【 0 1 0 8 】

(付記 5) 前記 1 : N カブラが、1 : 1 0 カブラであることを特徴とする、付記 4 記載の光導波路デバイス。

(付記 6) 前記複数の光導波路のうちの光導波路の出力側に設けられる 1 又は複数の導波路型カブラと、
前記複数の光導波路のうち他の光導波路の出力側に設けられる 1 又は複数の Y 分岐光導波路と、

前記導波路型カブラの一方のポートに連結される 1 又は複数のモニタ用光導波路とを備え、

20

前記複数の光検出部のうちの光検出部は、対応するモニタ用光導波路を通じて導かれるモニタ光の強度を検出し、他の光検出部は、対応する Y 分岐光導波路の分岐部分から放射された放射光の強度を検出することを特徴とする、付記 1 記載の光導波路デバイス。

【 0 1 0 9 】

(付記 7) 前記複数の光導波路が、いずれも出力側に Y 分岐光導波路を有するマッハツェンダ型光導波路であり、

前記複数の光検出部が、対応する前記 Y 分岐光導波路の分岐部分から放射される放射光の強度を検出するように、前記基板の出力側端面の厚さ方向に位置をずらして配設されていることを特徴とする、付記 1 記載の光導波路デバイス。

【 0 1 1 0 】

30

(付記 8) 前記複数のモニタ用光導波路のうちのモニタ用光導波路が、前記基板の側面まで延びるように形成され、

前記複数の光検出部のうちの光検出部が、前記一のモニタ用光導波路から出力される光を検出するように前記基板の側面に設けられていることを特徴とする、付記 2 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の光導波路デバイス。

【 0 1 1 1 】

(付記 9) 前記基板が、リチウムナイオベートにより構成されることを特徴とする、付記 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の光導波路デバイス。

(付記 1 0) 電気光学効果を有する基板と、
前記基板上に直列に形成される第 1 , 第 2 マッハツェンダ型光導波路と、
前記第 1 マッハツェンダ型光導波路に設けられ、クロック信号が供給される第 1 信号電極と、

40

前記第 2 マッハツェンダ型光導波路に設けられ、データ信号が供給される第 2 信号電極と、

前記第 1 マッハツェンダ型光導波路に設けられ、バイアス電圧を印加される第 1 バイアス電極と、

前記第 2 マッハツェンダ型光導波路に設けられ、バイアス電圧を印加される第 2 バイアス電極と、

前記第 1 マッハツェンダ型光導波路から出力される光の強度を検出する第 1 モニタ P D と、

50

前記第 2 マッハツェンダ型光導波路から出力される光の強度を検出する第 2 モニタ P D とを備えることを特徴とする、光変調器。

【 0 1 1 2 】

(付記 1 1) 前記第 1 マッハツェンダ型光導波路又は前記第 2 マッハツェンダ型光導波路の出力側に設けられる 3 d B カブラと、
前記第 1 マッハツェンダ型光導波路又は前記第 2 マッハツェンダ型光導波路から出力される光のうち前記 3 d B カブラによって分岐された光をモニタ光として前記第 1 モニタ P D 又は前記第 2 モニタ P D へ導くモニタ用光導波路と、
前記モニタ用光導波路を伝播するモニタ光を減衰させる減衰部とを備えることを特徴とする、付記 1 0 記載の光変調器。

10

【 0 1 1 3 】

(付記 1 2) 電気光学効果を有する基板と、
前記基板上に形成される光導波路と、
前記光導波路に設けられる電極と、
前記光導波路から出力される光の一部をモニタ光として導くモニタ用光導波路と、
前記モニタ用光導波路に設けられ、モニタ光を減衰させる減衰部と、
前記モニタ用光導波路を通じて導かれ、前記減衰部によって減衰されたモニタ光の強度を検出する光検出部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【 0 1 1 4 】

(付記 1 3) 前記光導波路が、マッハツェンダ型光導波路であり、
前記マッハツェンダ型光導波路の出力側に 3 d B カブラを備えることを特徴とする、付記 1 2 記載の光導波路デバイス。

20

(付記 1 4) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路を構成する曲率半径を小さくした曲がり導波路によって構成されることを特徴とする、付記 1 2 又は 1 3 記載の光導波路デバイス。

【 0 1 1 5 】

(付記 1 5) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路を構成する 2 つ以上の分岐部によって構成されることを特徴とする、付記 1 2 又は 1 3 記載の光導波路デバイス。

(付記 1 6) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路を構成する 1 : N カブラによって構成されることを特徴とする、付記 1 2 又は 1 3 記載の光導波路デバイス。

30

【 0 1 1 6 】

(付記 1 7) 前記減衰部が、前記モニタ用光導波路の端部付近に設けられるビーム拡大部によって構成されることを特徴とする、付記 1 2 ~ 1 6 のいずれか 1 項に記載の光導波路デバイス。

(付記 1 8) 前記モニタ用光導波路の端部付近にビーム拡大部を備えることを特徴とする、付記 1 2 ~ 1 6 のいずれか 1 項に記載の光導波路デバイス。

【 0 1 1 7 】

(付記 1 9) 前記ビーム拡大部が、前記モニタ用光導波路の端部を前記基板の端面又は側面から所定距離の位置とすることによって構成されることを特徴とする、付記 1 7 又は 1 8 記載の光導波路デバイス。

40

(付記 2 0) 前記ビーム拡大部が、前記モニタ用光導波路の端部を 2 分岐させることによって構成されることを特徴とする、付記 1 7 又は 1 8 記載の光導波路デバイス。

【 0 1 1 8 】

(付記 2 1) 電気光学効果を有する基板と、
前記基板上に直列に形成される複数のマッハツェンダ型又は方向性結合器型の光導波路と、
前記複数の光導波路毎に独立して設けられる複数の電極と、
前記複数の光導波路から出射される光の強度をそれぞれ独立して検出する複数の光検出部と、
前記複数の光検出部のうちの一の光検出部で検出された光の強度に基づいて、前記一の光

50

検出部に対応する前記光導波路に設けられる前記電極に印加されるバイアス電圧を制御するバイアス制御部とを備えることを特徴とする、光導波路デバイス。

【 0 1 1 9 】

【 発明の効果 】

以上詳述したように、本発明の光導波路デバイス及び光デバイスによれば、モニタ用光導波路を介してモニタ光を取り出すため、モニタ光を正確、かつ確実に検出でき、また、モニタ部として採用しうる部品の選択の幅が広がり、また、バイアス制御に用いるのに適正な強度のモニタ光が得られるという利点がある。

【 0 1 2 0 】

また、本発明の光導波路デバイス及び光デバイスによれば、複数のマッハツェンダ型干渉計のために設けられたモニタ部によって、それぞれ独立にモニタ光を検出し、これに基づいてバイアス制御を行なうため、バイアス制御を容易、かつ、正確に行なえるという利点がある。

【 図面の簡単な説明 】

【 図 1 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 2 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 3 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 4 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 5 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 6 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 7 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 8 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 9 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器に備えられる減衰部の他の構成例を模式的に示す拡大図である。

【 図 1 0 】本発明の第 1 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての光変調器における信号光及びモニタ光の光出力を示す図である。

【 図 1 1 】本発明の第 2 実施形態にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 2 】本発明の第 2 実施形態の第 1 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 3 】本発明の第 2 実施形態の第 2 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 4 】本発明の第 2 実施形態の第 3 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 5 】本発明の第 2 実施形態の第 4 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 6 】本発明の第 2 実施形態の第 5 変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 7 】本発明の第 2 実施形態の他の変形例にかかる光導波路デバイスとしての R Z 光変調器の全体構成を示す模式図である。

【 図 1 8 】バイアス制御に用いられるモニタ光をモニタ用光導波路を用いて取り出す方法について説明するための図である。

10

20

30

40

50

【図 19】モニタ用光導波路を用いてモニタ光を取り出す場合の課題を説明するための図であって、信号光及びモニタ光の光出力を示す図である。

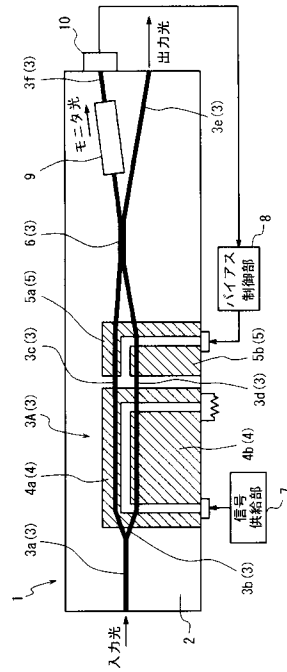
【図 20】RZ光変調器におけるバイアス制御を説明するための図である。

【符号の説明】

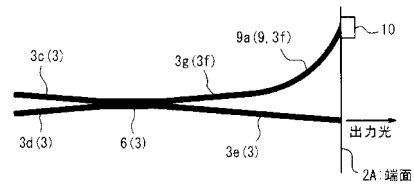
- 1 MZ型LN光変調器
- 2 基板
- 2A 端面
- 3A 光導波路(MZ型光導波路)
- 3 光導波路
- 3a 入力側光導波路 10
- 3b Y分岐光導波路
- 3c, 3d 直線状光導波路
- 3e 出力側光導波路
- 3f モニタ用光導波路
- 3g 直線状光導波路
- 3h 2分岐光導波路
- 4 主電極
- 4a 信号電極
- 4b 接地電極
- 5 バイアス電極 20
- 5a 電極
- 5b 接地電極
- 6 3dBカプラ(導波路型カプラ)
- 7 データ信号供給部(信号供給部)
- 8 バイアス制御部
- 9 減衰部
- 9a 曲がり導波路
- 9b 分岐光導波路(複数の分岐光導波路, 多分岐光導波路)
- 9c 1:Nカプラ
- 9d ビーム拡大部 30
- 10 モニタPD(フォトディテクタ, バイアス制御用モニタPD, 光検出部)
- 20 RZ光変調器
- 21, 41 マッハツェンダ型光変調器(MZ型LN光変調器)
- 22 基板
- 23 第1光導波路
- 23b, 23c 直線状光導波路
- 23d モニタ用光導波路
- 24 第2光導波路
- 24a Y分岐光導波路(分岐光導波路)
- 24b, 24c 直線状光導波路 40
- 24d モニタ用光導波路
- 25 第1電極(主電極)
- 25a 信号電極
- 25b 接地電極
- 26 第1バイアス電極
- 26a 電極
- 26b 接地電極
- 27 第2電極(主電極)
- 27a 信号電極
- 27b 接地電極 50

2 8	第 2 バイアス電極	
2 8 a	電極	
2 8 b	接地電極	
2 9 a	3 d B カプラ (導波路型カプラ)	
2 9 b	3 d B カプラ (導波路型カプラ)	
2 9 c	3 d B カプラ (導波路型カプラ)	
3 0	入力側光導波路	
3 1	中間光導波路	
3 2	出力側光導波路	
3 3	クロック信号供給部 (信号供給部)	10
3 4	N R Z データ信号供給部 (信号供給部)	
3 5	第 1 バイアス制御部	
3 6	第 2 バイアス制御部	
3 7	第 1 モニタ P D (光検出部)	
3 8	第 2 モニタ P D (光検出部)	
6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0	R Z 光変調器	
6 1 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 8 1 , 8 3 , 9 1 , 9 3	Y 分岐光導波路	
8 2 , 8 4 , 9 2 , 9 4	1 : N カプラ (例えば 1 : 1 0 カプラ, 導波路型光カプラ)	
9 5	可変減衰器	
9 6	光導波路	20
9 6 a , 9 6 d	Y 分岐光導波路	
9 6 b , 9 6 c	直線状光導波路	
9 7	電極	
9 8	バイアス電極	
9 9	1 : N カプラ (例えば 1 : 1 0 カプラ, 導波路型光カプラ)	
1 0 0	第 3 モニタ用光導波路	
1 0 1	第 3 モニタ P D (光検出部)	
1 0 2	Y 分岐光導波路	

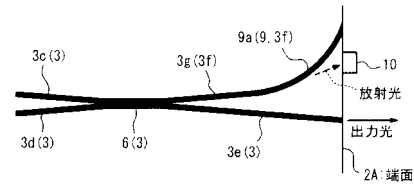
【図 1】



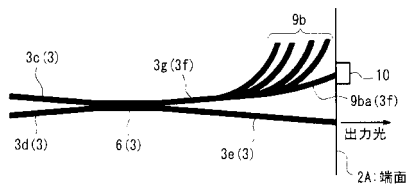
【図 2】



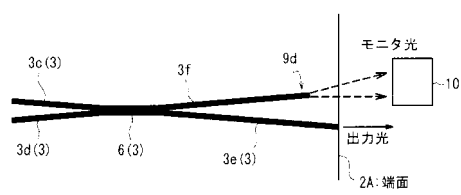
【図 3】



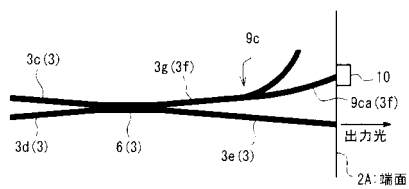
【図 4】



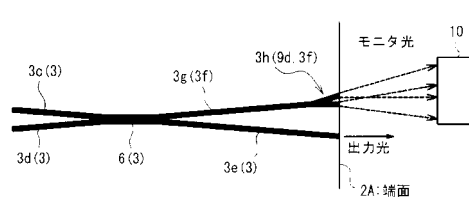
【図 6】



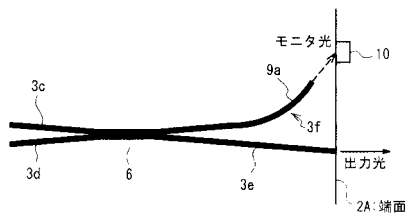
【図 5】



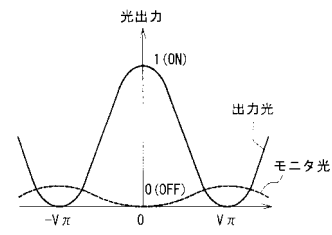
【図 7】



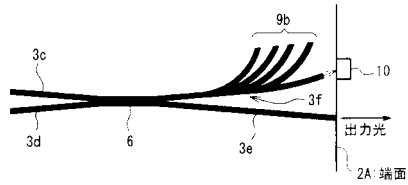
【図 8】



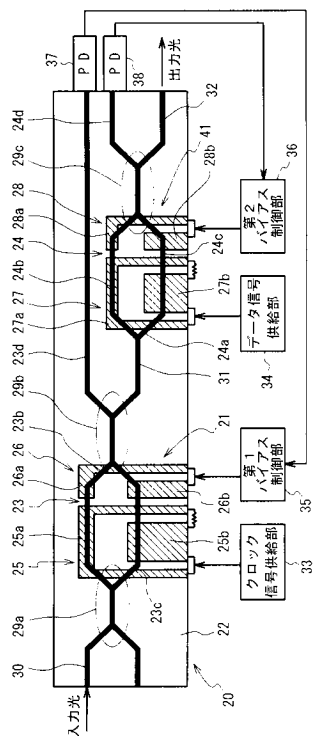
【図 10】



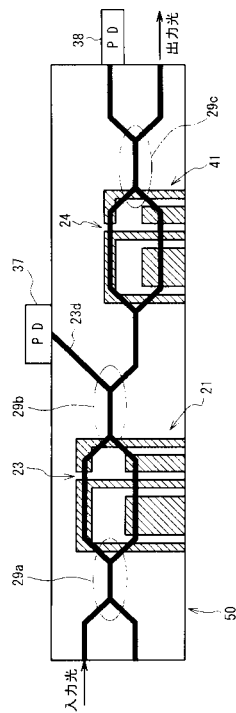
【図 9】



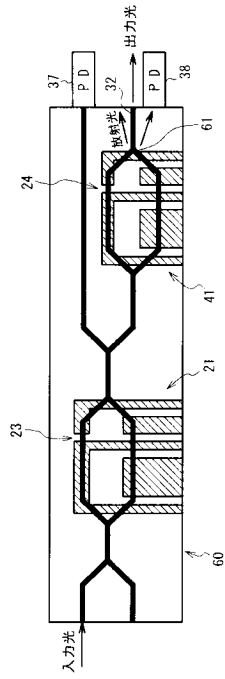
【図 11】



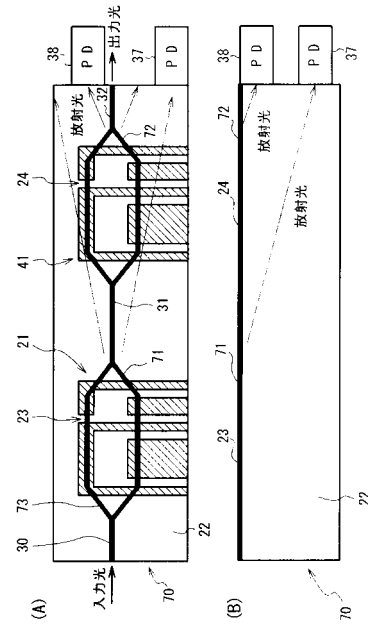
【図 12】



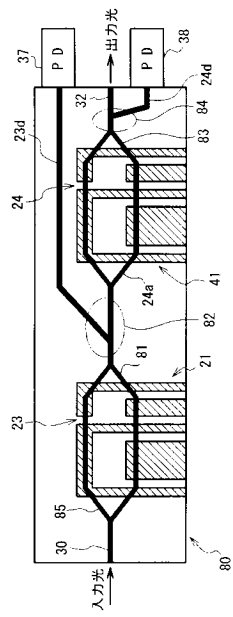
【図 13】



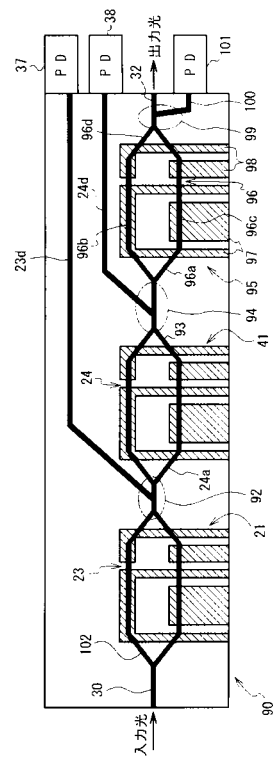
【図 14】



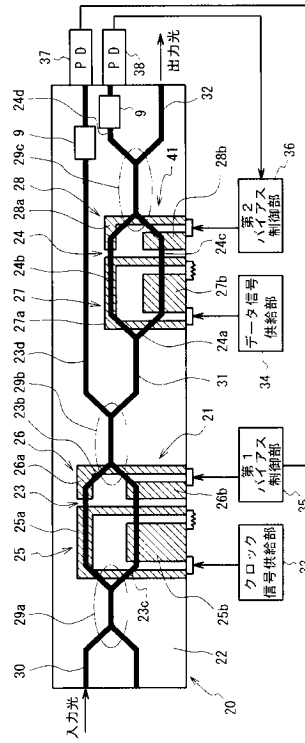
【図 15】



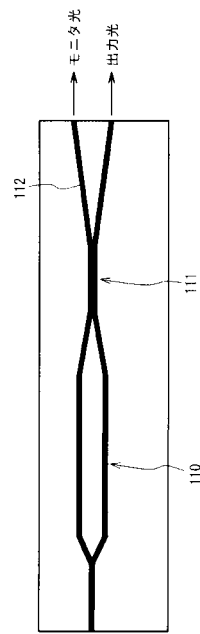
【図 16】



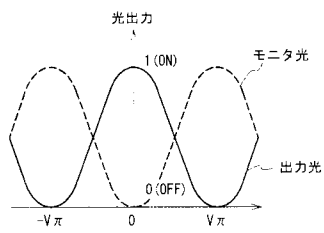
【図 17】



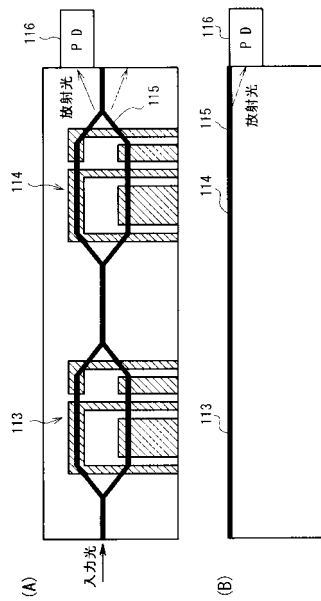
【図 18】



【図 19】



【図 20】



フロントページの続き

審査官 小林 和幸

- (56)参考文献 特開平08-146366(JP,A)
特開平03-145623(JP,A)
特開平05-053086(JP,A)
特開2002-023123(JP,A)
特開平10-123471(JP,A)
特開昭61-080109(JP,A)
特開2001-296506(JP,A)
特開2001-209018(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F 1/00-1/125
G02B 6/12-6/14
H04B 10/00